

БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР КТ805АМ/БМ

Предельные параметры ($T_A = 25\text{ }^\circ\text{C}$)

Параметр	Обозначение	КТ805АМ/БМ	Ед. изм.
Напряжение коллектор-база	V_{CBO}	100/80	В
Напряжение коллектор-эмиттер	V_{CEO}	60/60	В
Напряжение эмиттер-база	V_{EBO}	5/5	В
Ток коллектора	I_C	5/5	А
Максимальный ток коллектора	$I_{C(\text{peak})}$	8/8	А
Ток базы	I_B	2/2	А
Максимальная мощность рассеяния	P_C	30/30	Вт
Температура перехода	T_J	150	$^\circ\text{C}$
Температура хранения	T_{stg}	-60 до +100	$^\circ\text{C}$

Электрические характеристики

Параметр	Обозначение	Условия измерения	КТ805АМ/БМ			Ед. изм.
			Мин.	Тип.	Макс.	
Обратный ток коллектора	I_{CBO}	$V_{CB}=100/80\text{ В}, I_B=0$	-	-	3/3	мА
Обратный ток эмиттера	I_{EBO}	$V_{EB}=5\text{ В}, I_C=0$	-	-	5/5	мА
Статический коэфф. передачи по току	h_{FE}	$V_{CE}=10\text{ В}, I_C=2\text{ А}$	15/15	-	-	-
Напряжение насыщ. база-эмиттер	$V_{BE(\text{sat})}$	$I_B=0.5\text{ А}, I_C=5\text{ А}$	-	-	2.5/5	В
Напряжение насыщ. коллектор-эмиттер	$V_{CE(\text{sat})}$	$I_C=5/2\text{ А}, I_B=2/0.2\text{ А}$	-	-	2.5/5	В
Предельная частота коэффициента передачи тока	f_T	$V_{CE}=10\text{ В}, I_C=1\text{ А}$ $f=10\text{ МГц}$	20/20	-	-	МГц
Обратный ток коллектора	I_{CES}	$V_{CE}=100/80\text{ В}, V_{EB}=0$	-	-	2/2	мкА